
	<h2>SI3590DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3590DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3590DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 79709 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3590DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	79709 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 2.5A, 1.7A 830mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A, 1.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3590DV-T1-GE3CT

SI3590DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3590DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3590DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3590DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3588DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3588DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3685DV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI3801DV T1 01 VISHAY VISHAY SOT-163</p>
 <p>SI3801DV T1 013AA VISHAY VISHAY SOT-163</p>	 <p>SI3590DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6TSOP</p>	 <p>SI3801DV 012A4 SI SI SOT-163</p>	 <p>SI3590DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3552DV-T1	SI3552DV-T1-E3	SI3552DV-T1-E3	SI3552DV-T1-GE3	SI3552DV-T1-GE3
SI3585CDV	SI3585CDV-T1-GE3	SI3585CDV-T1-GE3	SI3585DV	SI3585DV-T1
SI3585DV-T1-E3	SI3585DV-T1-E3	SI3585DV-T1-GE3	SI3585DV-T1-GE3	SI3586DS-TI-E3
SI3586DV	SI3586DV-T1-E3	SI3586DV-T1-E3	SI3586DV-T1-GE3	SI3586DV-T1-GE3
SI3588DV	SI3588DV-T1-E3	SI3588DV-T1-E3	SI3588DV-T1-GE3	SI3588DV-T1-GE3
SI3590DV-T1-GE3	SI3801DV-T1	SI3803DV-T1	SI3805DV-T1	SI3805DV-T1-E3
SI3805DV-T1-E3	SI3812DV-T1-GE3	SI3812DV-T1-GE3	SI3850ADV-T1-E3	SI3850ADV-T1-E3
SI3850ADV-T1-GE3	SI3850ADV-T1-GE3	SI3850DV-T1	SI3850DV-T1-E3	SI3850DV-T1-GE3
SI3851DV	SI3851DV-T1	SI3851DV-T1-E3	SI3851DV-T1-E3	SI3851DV-T1-GE3
SI3853DV-T1-E3	SI3853DV-T1-E3	SI3861BDV-T1-GE3	SI3861BDV-T1-GE3	SI3861DV-NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited